日本国特許庁

TPOO/OZ891

REO'D 2 6 JUN 2000

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて ギンいる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 5月10日

EU

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第128732号

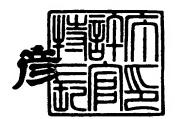
工業技術院長 財団法人 化学技術戦略推進機構

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 6月 9日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆



出証番号 出証特2000-3042402

【書類名】

特許願

【整理番号】

JP-11390

【提出日】

平成11年 5月10日

【あて先】

特許庁長官 伊佐山 建志 殿

【国際特許分類】

C08F 4/64

C08F 10/00

C08F297/00

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】

曽我 和雄

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】

浅井 道彦

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】

鈴木 靖三

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】

宮沢 哲

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】

土原 健治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都文京区水道二丁目3番15-504号

特平11-1287

【氏名】 村田 昌英

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市小野川四丁目6-202号

【氏名】 尾崎 裕之

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市竹園二丁目6番2-203号

【氏名】 川辺 正直

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市松代五丁目2-2号

【氏名】 加瀬 俊男

【発明者】

【住所又は居所】 石川県金沢市3-14-4 ひろみハイツ201

【氏名】 金 ▲ジ▼洙

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市天久保2-6-14 桜井ハイツ203

【氏名】 萩原 英昭

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市二の宮四丁目6番3-507号

【氏名】 福井 祥文

【特許出願人】

【識別番号】 000001144

【氏名又は名称】 工業技術院長 佐藤 壮郎

【特許出願人】

【識別番号】 597071652

【氏名又は名称】 財団法人 化学技術戦略推進機構

【指定代理人】

【識別番号】 220000390

【氏名又は名称】 工業技術院 物質工学工業技術研究所長 久保田 正明

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の指定代理人

特平11-128732

【代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 財団法人 化学技術戦略推進機構の 代理人

【復代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の復代理人

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【代理関係の特記事項】 特許出願人 財団法人 化学技術戦略推進機構 の代理人

【選任した復代理人】

【識別番号】 100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の復代理人

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001627

【納付金額】 13,860円

【その他】 国以外のすべての者の持分の割合66/100

特平11-1287

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 オレフィン系リビング重合体の製法およびシクロペンタジエニルハフニウムメチルジクロライド

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A-1)1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウム含有化合物、

(B) (B-1) 一般式(I):

$$B(Ph)_{3} \qquad (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

(B-2) 一般式(II):

$$B^-(Ph)_{A}X^+$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および場合により

(C) 一般式 (III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、nは0.1または2)で表わされるアルミニウム化合物

からなる触媒を用いて重合温度 - 20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させて分子量分布(Mw/Mn)が1~1.3の重合体を得ることを特徴とするオレフィン系リビング重合体の製法。

【請求項2】 重合温度が−30~−80℃である請求項1記載の製法。

【請求項3】 重合温度が-40~-80℃である請求項1記載の製法。

【請求項4】 (A-2) 1 個または2 個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、

(B) (B-1) 一般式(I):

$$B(Ph)_{3} \qquad (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

(B-2) 一般式 (II):

$$B^{-}(Ph)_{A}X^{+}$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および場合により

(C) 一般式 (III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、nは0.1または2)で表わされるアルミニウム化合物

からなる触媒を用いて重合温度-60~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させて分子量分布(Mw/Mn)が1~1.3の重合体を得ることを特徴とするオレフィン系重合体の製法。

【請求項5】 重合温度が-60~-80℃である請求項4記載の製法。

【請求項6】 一般式(I)または(II)中のPh基が、 $1\sim5$ 個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4または5記載の製法。

【請求項7】 一般式(I)または(II)中のPh基が、5個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4または5記載の製法。

【請求項8】 一般式(III)中のnが0である請求項1、2、3、4、5、6または7記載の製法。

【請求項9】 一般式(III) 中のnが0であり、Rが炭素数4~8のアルキル基である請求項1、2、3、4、5、6または7記載の製法。

【請求項10】 オレフィン系モノマーが炭素数 $2\sim200\alpha$ ーオレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8または<math>9記載の製法。

【請求項11】 オレフィン系モノマーが炭素数 $2 \sim 100$ α - オレフィンである請求項 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8または 9 記載の製法。

【請求項12】 オレフィン系モノマーが炭素数3~6の α -オレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8または9記載の製法。

【請求項13】 重合体が析出しない範囲で重合を行なうことを特徴とする 請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11または12記載の製法 【請求項14】 分子量分布が1~1.2である請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12または13記載の製法。

【請求項15】 シクロペンタジエニルハフニウムメチルジクロライド。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、オレフィン系リビング重合体の製法およびシクロペンタジエニルハフニウムメチルジクロライドに関する。さらに詳しくは、分子量分布のせまい末端官能化ポリマーやブロックコポリマーに変換し得るオレフィン系リビング重合体の製法および重合触媒の1成分として用いるシクロペンタジエニルハフニウムメチルジクロライドに関する。

[0002]

【従来の技術】

[0003]

【化1】

 $([ArN = C - C = NAr] NiBr_2) / メチルアルミノキサン触媒$

(Ar は 2,6 - ジイソプロピルフェニル基)

[0004]

[NON] ZrMe2錯体:

[0005]

【化2】

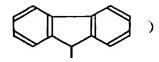
$$CH_3(CD_3)_2CN$$
 CH_3CH_3
 CH_3CH_3

[0006]

 $[t\,B\,u\,N\,S\,i\,M\,e\,_2\,F\,l\,u\,]\,\,T\,i\,M\,e\,_2/B\,\,(C_6\,F_5)\,_3$ 触媒($t\,B\,u\,d\,t\,-\,\mathcal{I}$ チル基、 $M\,e\,d\,\mathcal{I}$ チル基、 $F\,l\,u\,d\,$

[0007]

【化3】



[0008]

を用い、低温で [r] = 0. 65程度のシンジオリッチなプロピレンリビング重合体を製造した例(ポリマー・プレプリント・ジャパン($polym \cdot Prepr.$, Japan.,) $\underline{46}$ 1601(1997)) などが報告されている(たとえば高分子、47巻、2月号、74~77頁(1998年)参照)。

[0009]

また、チタン、ジルコニウムおよびハフニウムのビス(シクロペンタジエニル)誘導体などのメタロセン成分(第1成分)とプロトン供与性カチオンおよび混和性非配位性アニオンを有する第2成分との反応生成物である触媒に、-5~+10℃で第1のオレフィン成分を接触させて第1のリビングポリマーを製造し、ついで第2のモノマーを逐次添加して第1のポリマーと共重合させて分子量分布1.4~1.8のマルチブロックコポリマーを製造した例が報告されている(特表平5-503546号公報)。

[0010]

さらに、シクロペンタジェニルIVB族金属/アルモキサンまたは相溶性の非配位アニオンの反応生成物である触媒を用い、-5~+10℃で1種以上のオレフィン性モノマーを重合させ、分子量分布1.35~4.1のブロックコポリマーまたはテーパー状コポリマーを製造した例が報告されており、前記シクロペンタジェニルIVB族金属を形成する金属の例として、Ti、Zr、Hfなどが記載されている(特表平9-500150号公報)。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、たとえば前記 $[(2, 6-i Pr_2 C_6 H_3) N (CH_2)_3 N (2, 6-i Pr_2 C_6 H_3)] TiMe_2/B (C_6 F_5)_3 触媒や前記Niの嵩高い$

アリール基含有ジイミン錯体/メチルアルミノキサン触媒を用いる場合にはともに、触媒が複雑で製造しにくく、規則性が低いという問題がある。また、前記 [$t\,B\,u\,N\,S\,i\,M\,e\,_2\,F\,l\,u\,]\,T\,i\,M\,e\,_2/\,B\,(C_6\,F_5)\,_3$ 触媒を用い、低温でシンジオリッチなリビング重合体を製造する場合も、立体規則性が低く、さらに触媒の構造が複雑で製造しにくいという問題がある。

[0012]

また、メタロセン成分/プロトン供与性カチオンおよび混和性非配位性アニオンを有する第2成分の反応生成物である触媒を使用する場合、およびシクロペンタジェニルIVB族金属/アルモキサンまたは相溶性の非配位アニオンの反応生成物である触媒を用いる場合、いずれも分子量分布を必ずしもせまくすることができなかったり、また、必ずしも高度なリビング重合体を得ることができず、末端官能化ポリマー、ブロックコポリマーなどを用いる分野においては、さらに分子量分布のせまい重合体または高度なリビング重合体が望まれている。

[0013]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記従来技術の問題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウムまたはジルコニ ウム含有化合物、置換されていてもよいフェニル基を有するボラン化合物または ボレート化合物および場合により特定のアルキルアルミニウム化合物からなる触 媒を用いて、低温でオレフィン系モノマーを重合させた場合、分子量分布が1. 3以下のオレフィン系リビング重合体を製造し得ることを見出し、本発明を完成 するに至った。

[0014]

すなわち、本発明は、

(A-1)1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウム含有 化合物、

(B) (B-1) 一般式(I):

 $B(Ph)_{3} (I)$

(式中、 Phは置換されていてもよいフェニル基) で表わされるボラン化合物ま

たは

(B-2) 一般式 (II):

$$B^-(Ph)_4X^+$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および場合により

(C) 一般式 (III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n \qquad (III)$$

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、nは0.1または2)で表わされるアルミニウム化合物

からなる触媒を用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させて分子量分布(Mw/Mn)が1~1.3の重合体を得ることを特徴とするオレフィン系リビング重合体の製法(請求項1)、

重合温度が-30~-80℃である請求項1記載の製法(請求項2)、

重合温度が−40~−80℃である請求項1記載の製法(請求項3)、

(A-2)1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含 有化合物、

(B) (B-1) 一般式(I):

$$B(Ph)_{3} (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

(B-2) 一般式 (II):

$$B^-(Ph)_AX^+$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および場合により

(C) 一般式(III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数 $4\sim2$ 0の炭化水素基、nは 0. 1または 2)で表わされるアルミニウム化合物

からなる触媒を用いて重合温度-60~-100℃で炭素数2~20のオレフィ

ン系モノマーを重合させて分子量分布(Mw/Mn)が $1\sim1$. 3の重合体を得ることを特徴とするオレフィン系重合体の製法(請求項4)、

重合温度が-60~-80℃である請求項4記載の製法(請求項5)、

- 一般式(I)または(II)中のPh基が、 $1\sim5$ 個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4または5記載の製法(請求項6)、
- 一般式(I) または(II) 中のPh基が、5個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4または5記載の製法(請求項7)、
- 一般式 (III) 中のnが0である請求項1、2、3、4、5、6または7記載の 製法 (請求項8)、
- 一般式 (III) 中のnが0であり、Rが炭素数4~8のアルキル基である請求項 1、2、3、4、5、6または7記載の製法(請求項9)、

オレフィン系モノマーが炭素数 $2\sim20$ の α - オレフィンである請求項 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 または 9 記載の製法(請求項 1 0)、

オレフィン系モノマーが炭素数 $2\sim10$ の α ーオレフィンである請求項 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 または 9 記載の製法(請求項 1 1)、

オレフィン系モノマーが炭素数 $3\sim6$ の α ーオレフィンである請求項 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 または 9 記載の製法(請求項 1 2)、

重合体が析出しない範囲で重合を行なうことを特徴とする請求項1、2、3、4 、5、6、7、8、9、10、11または12記載の製法(請求項13)、

分子量分布が1~1.2である請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、1 0、11、12または13記載の製法(請求項14)、および シクロペンタジエニルハフニウムメチルジクロライド(請求項15) に関する。

[0015]

なお、オレフィン系モノマーの重合には単独重合だけではなく、オレフィン系 モノマー同士の共重合も含める。

[0016]

【発明の実施の形態】

本発明では、

- (A) (A-1) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウム含有化合物または(A-2) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、
- (B) (B-1) 一般式(I):

$$B (Ph)_3 (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

$$B^-(Ph)_{\Delta}X^+$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および場合により

(C) 一般式 (III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、nは0.1または2)で表わされる アルミニウム化合物

からなる触媒を用いてオレフィン系モノマーを重合させてオレフィン系リビング 重合体が製造される。

前記オレフィン系モノマーとしては、炭素数2~20、さらには2~10、と くには3~6のものが使用され、αーオレフィンが好ましい。

前記オレフィン系モノマーの具体例としては、エチレン、プロピレン、1-ブテン、3-メチルー1-ブテン、1-ペンテン、3-メチルー1-ペンテン、4-メチルー1-ペンテン、3-エチルー1-ペンテン、4-メチルー1-ペンテン、1-ヘキセン、1-ヘキセン、1-ヘキセン、1-スチルー1-ヘキセン、1-スチルー1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコセンなどの鎖状 $\alpha-$ オレフィン、1, 4-ペンタジエン、1, 4-ヘキサジエン、1, 5-ヘキサジエン、1, 7-オクタジエン、1,

8-ノナジエン、1,9-デカジエンなどの鎖状ジエン、シクロプロペン、シクロブテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロデセン、シクロドデセン、シクロテトラデセン、シクロエイコセン、3-メチルシクロペンテン、3-メチルシクロペンキセン、ビニルシクロヘキサン、1,2-ジヒドロジシクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、ノルボルネン、1-メチルノルボルネン、5-メチルノルボルネン、7-メチルノルボルネン、5-エチルノルボルネン、5-エチルノルボルネン、5-エチリデンノルボルネン、5-ビニルノルボルネン、5ーベンジルノルボルネン、5-エチリデンノルボルネン、5,5,6-トリメチルノルボルネンなどの環状オレフィンまたは環状ジエンなどがあげられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。2種以上を組み合わせて用いる場合には、各モノマーはランダム重合していてもよくブロック重合していてもよい。前記モノマーのうちでは、エチレン、プロピレン、ブテン、ヘキセン、オクテン、シクロペンテン、ノルボルネンが工業的に入手しやすく安価である点から好ましい。

[0019]

前記(A)~(B)成分および場合により(C)成分からなる触媒は、容易に 製造することができる比較的安定な触媒であり、炭素数2~20のオレフィン系 モノマー、とくにプロピレンのリビング重合、場合により立体規則性リビング重 合の触媒となる。

[0020]

前記1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウム含有化合物(A-1)または1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物(A-2)(以下、IVB族化合物(A)ともいう)としては、

一般式(I):

$$C_{p}M^{1}R^{1}R^{2}R^{3}$$
 (1)

一般式(II):

$$C_{P_2}M^1R^1R^2$$
 (II)

一般式(III):

 $(C_p - A_e - C_p) M^1 R^1 R^2$ (III)

(式(I)、(III)中、 M^1 はZrまたはHf原子、Cpは置換されていてもよいシクロペンタジエニル骨格、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれぞれ σ 結合性の配位子、キレート性の配位子、Aは共有結合性の2価の基、eは $1\sim3$ の整数、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれらの2つ以上が互いに結合して環を形成していてもよい、一般式(II)および(III)において、2つのCpは同一であってもよく、互いに異っていてもよい)

で示される化合物またはこれらの誘導体が好適に使用される。これらは単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて使用してもよい。

[0021]

前記置換されていてもよいシクロペンタジエニル骨格としては、他にインデニル基、置換インデニル基、テトラヒドロインデニル基、置換テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基、オクタヒドロフルオレニル基、置換フルオレニル基があげられる。前記置換されていてもよいシクロペンタジエニル骨格が置換基を有する場合の置換基としては、炭素数1~20の炭化水素基、たとえばアルキル基が好ましい。

[0022]

前記置換シクロペンタジエニル骨格としては、たとえばメチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、イソプロピルシクロペンタジエニル基、テリメチルシクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、トリメチルシリロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、プロピルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、ベキシルシクロペンタジエニル基、シクロヘキシルシクロペンタジエニル基、ベンジルシクロペンタジエニル基、ジフェニルシクロペンタジエニル基、ベンダルシクロペンタジエニル基、ジフェニルシクロペンタジエニル基、ペンタ(トリメチルシリル)シクロペンタジエニル基、ドリメチルゲルミルシクロペンタジエニ

ル基、トリメチルスタンニルシクロペンタジエニル基、トリフルオロメチルシクロペンタジエニル基などがあげられる。

[0023]

前記 σ 結合性の配位子としては、水素原子;フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子;メチル基、エチル基、nープロピル基、is οープロピル基、nーブチル基、ネオペンチル基、シクロヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノルボルニル基などの炭素数 1~20の炭化水素基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、フェノキシ基などの炭素数 1~20のアルコキシ基;フェニル基、トリル基、キシリル基、ベンジル基、ジフェニルメチル基などの炭素数 6~20のアリール基、アルキルアリール基もしくはアリールアルキル基;アリル基、置換アリル基;トリメチルシリル基、フェニルジメチルシリル基、トリフェニルシリル基、トリ(ジメチルシリル)シリル基、(トリメチルシリル)メチル基などのケイ素原子を含む置換基などがあげられる。後述するアルミニウム化合物(C)を用いない場合には、前記水素原子、炭素数 1~20の炭化水素基、炭素数 6~20のアリール基、アルキルアリール基もしくはアリールアルキル基、アリル基、置換アリル基、ケイ素原子を含む置換基のうちの少なくとも1つを含む必要がある。

[0024]

前記キレート性の配位子としては、アセチルアセトナート基、置換アセチルア セトナート基などがあげられる。

[0025]

また、一般式(III)中のAで示される共有結合性の2価の基としては、たとえばメチレン基、ジメチルメチレン基、エチレン基、イソプロピリデン基、シクロブチリデン基、シクロペンチリデン基、シクロヘキシリデン基、ジメチルシリレン基、ジメチルゲルミレン基、ジメチルスタニレン基、フェニル(メチル)メチレン基、フェニル(メチル)シリレン基、ジフェニルメチレン基、ジフェニルシリレン基などがあげられる。

[0026]

前記一般式(III)で示される架橋ジシクロペンタジエニル化合物が、C₁対称

性、 C_2 対称性または C_s 対称性を有する化合物の場合には、立体規則性の高いリビング重合体を得ることができる。

[0027]

一般式(I)~(III)で表わされるIVB族化合物(A)の具体例としては、 たとえば下記のものがあげられる。

[0028]

一般式(I)で表わされる化合物としては、たとえば(シクロペンタジエニル)トリメチルジルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリフェニルジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル)トリベンジルジルコニウム、(シクロペンタジエ ニル)トリクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリメトキシジルコ ニウム、(シクロペンタジエニル)ジメチル(メトキシ)ジルコニウム、シクロ ペンタジエニルメチルジクロロジルコニウム、 (メチルシクロペンタジエニル) トリメチルジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニル)トリフェニルジルコ ニウム、(メチルシクロペンタジエニル)トリベンジルジルコニウム、(メチル シクロペンタジエニル)トリクロロジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニ ル)ジメチル(メトキシ)ジルコニウム、(ジメチルシクロペンタジエニル)ト リメチルジルコニウム、(トリメチルシクロペンタジエニル)トリメチルジルコ ニウム、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)トリメチルジルコニウム、 (テトラメチルシクロペンタジエニル)トリメチルジルコニウム、(ペンタメチ ルシクロペンタジエニル)トリメチルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペン タジエニル)トリフェニルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリベンジルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリクロ ロジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリメトキシジルコニ ウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ジメチル(メトキシ)ジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル)トリエチルジルコニウム、(シクロペンタジエニ ル) トリプロピルジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリネオペンチルジ ルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリ(ジフェニルメチル)ジルコニウム 、(シクロペンタジエニル)ジメチルヒドリドジルコニウム、(シクロペンタジ エニル) トリエトキシジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリイソプロポ

キシジルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリフェノキシジルコニウム、(シクロペンタジエニル)ジメチルイソプロポキシジルコニウム、(シクロペンタ ジエニル)ジフェニルイソプロポキシジルコニウム、(シクロペンタジエニル) ジメトキシクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニル)メトキシジクロロジ ルコニウム、(シクロペンタジエニル)ジフェノキシクロロジルコニウム、(シ クロペンタジエニル)フェノキシジクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニ ル) トリ(フェニルジメチルシリル) ジルコニウム、(n-ブチルシクロペンタ ジエニル) ジメチル n - ブトキシジルコニウム、 (ベンジルシクロペンタジエニ ル)ジェートリルメチルジルコニウム、(トリフルオロメチルシクロペンタジエ ニル) トリベンジルジルコニウム、(ジフェニルシクロペンタジエニル) ジノル ボルニルメチルジルコニウム、(テトラエチルシクロペンタジエニル)トリベン **ジルジルコニウム、(ペンタトリメチルシリルシクロペンタジエニル)トリベン** ジルジルコニウム、 (ペンタメチルシクロペンタジエニル) トリネオペンチルジ ルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)メチルジクロロジルコニウ ム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリエトキシジルコニウム、(ペン タメチルシクロペンタジエニル)トリフェノキシジルコニウム、(ペンタメチル シクロペンタジエニル)メトキシジクロロジルコニウム、(ペンタメチルシクロ ペンタジエニル)ジフェノキシクロロジルコニウム、(ペンタメチルシクロペン タジエニル)フェノキシジクロロジルコニウム、(インデニル)トリメチルジル コニウム、 (インデニル) トリベンジルジルコニウム、 (インデニル) トリクロ ロジルコニウム、(インデニル)トリメトキシジルコニウム、(インデニル)ト リエトキシジルコニウムおよびこれら化合物のジルコニウムをハフニウムで置換 した化合物、たとえばシクロペンタジエニルトリメチルハフニウムなどがあげら れる。

[0029]

一般式 (II) で表わされる化合物としては、たとえばビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジフェニルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジエチルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジメト

キシジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル)ジヒドリドジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニ ル)クロロヒドリドジルコニウム、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジメチ ルジルコニウム、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジベンジルジルコニウム 、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス(ペンタメ チルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロ ペンタジエニル) ジベンジルジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジ エニル) ジクロロジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ク ロロメチルジルコニウム、ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ヒドリド メチルジルコニウム、(シクロペンタジエニル)(ペンタメチルシクロペンタジ エニル) ジメチルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジネオペンチル ジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジェートリルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジャートリルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエ **ニル) ビス(ジフェニルメチル)ジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)** ジブロモジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)メチルクロロジルコニウ ム、ピス(シクロペンタジエニル)エチルクロロジルコニウム、ビス(シクロペ ンタジエニル) シクロヘキシルクロロジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニ ル) フェニルクロロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ベンジルクロ ロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ヒドリドメチルジルコニウム、 ビス (シクロペンタジエニル) メトキシクロロジルコニウム、ビス (シクロペン タジエニル)エトキシクロロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)(ト リメチルシリル)メチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ビス(ト リメチルシリル) ジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) (トリフェニル シリル)メチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)(トリス(ジメチ ルシリル)シリル)メチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)(トリ メチルシリル) (トリメチルシリルメチル) ジルコニウム、ビス (メチルシクロ ペンタジエニル)ジフェニルジルコニウム、ビス(エチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (エチルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコ ニウム、ビス(プロピルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(

プロピルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (n-ブチルシク ロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス(tーブチルシクロペンタジエ ニル)ビス(トリメチルシリル)ジルコニウム、ビス(ヘキシルシクロペンタジ エニル)ジクロロジルコニウム、ビス(シクロヘキシルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコ ニウム、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル) エトキシクロロジルコニウム、ビス (エチルメ チルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス(プロピルメチルシク ロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス(ブチルメチルシクロペンタジ エニル)ジクロロジルコニウム、ビス(トリメチルシクロペンタジエニル)ジク ロロジルコニウム、ビス(テトラメチルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコ ニウム、ビス(シクロヘキシルメチルシクロペンタジエニル)ジベンジルジルコ ニウム、ビス (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム 、ビス(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス **(トリメチルゲルミルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(ト** リメチルゲルミルシクロペンタジエニル)ジフェニルジルコニウム、ビス(トリ **メチルスタンニルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(トリメ** チルスタンニルシクロペンタジエニル)ジベンジルジルコニウム、ビス(トリフ ルオロメチルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(トリフルオ ロメチルシクロペンタジエニル)ジノルボルニルジルコニウム、ビス(インデニ ル) ジベンジルジルコニウム、ビス (インデニル) ジクロロジルコニウム、ビス (インデニル) ジブロモジルコニウム、ビス (テトラヒドロインデニル) ジクロ ロジルコニウム、ビス(フルオレニル)ジクロロジルコニウム、(プロピルシク ロペンタジエニル)(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、(シクロ ヘキシルメチルシクロペンタジエニル)(シクロペンタジエニル)ジベンジルジ ルコニウム、(ペンタトリメチルシリルシクロペンタジエニル)(シクロペンタ ジエニル)ジメチルジルコニウム、(トリフルオロメチルシクロペンタジエニル)(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウムおよびこれら化合物のジルコ ニウムをハフニウムで置換した化合物、たとえばビス(シクロペンタジエニル)

ジメチルハフニウムなどがあげられる。

[0030]

一般式(III)で表わされる化合物としては、たとえばエチレンビス(インデ ニル) ジメチルジルコニウム、エチレンビス(インデニル)ジクロロジルコニウ ム、エチレンビス(テトラヒドロインデニル)ジメチルジルコニウム、エチレン ビス(テトラヒドロインデニル)ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス (シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ジメチルシリレンビス(シク ロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、イソプロピリデン(シクロペンタジ エニル)(9-フルオレニル)ジメチルジルコニウム、イソプロピリデン(シク ロペンタジエニル)(9-フルオレニル)ジクロロジルコニウム、「フェニル(メチル) メチレン] (9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジ ルコニウム、ジフェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(9-フルオレニル) ジメチルジルコニウム、エチレン(9-フルオレニル)(シクロペンタジエニ ル) ジメチルジルコニウム、シクロヘキシリデン(9-フルオレニル)(シクロ ペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、シクロペンチリデン (9-フルオレニ ル) (シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、シクロブチリデン(9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ジメチルシリ レン(9-フルオレニル)(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ジ メチルシリレンピス(2,3,5-トリメチルシクロペンタジエニル)ジメチル ジルコニウム、ジメチルシリレンビス(2,3,5-トリメチルシクロペンタジ エニル)ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス(インデニル)ジクロロ ジルコニウム、メチレンビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、 メチレンビス(シクロペンタジエニル)ジ(トリメチルシリル)ジルコニウム、 メチレン(シクロペンタジエニル)(テトラメチルシクロペンタジエニル)ジメ チルジルコニウム、メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジメチ ルジルコニウム、エチレンビス(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム 、エチレンビス(シクロペンタジエニル)ジベンジルジルコニウム、エチレンビ ス(シクロペンタジエニル)ジヒドリドジルコニウム、エチレンビス(インデニ ル) ジフェニルジルコニウム、エチレンピス(インデニル)メチルクロロジルコ

ニウム、エチレンビス(テトラヒドロインデニル)ジベンジルジルコニウム、イ ソプロピリデン(シクロペンタジエニル)(メチルシクロペンタジエニル)ジク ロロジルコニウム、イソプロピリデン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロ フルオレニル) ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレンビス (シクロペンタ ジエニル) ジネオペンチルジルコニウム、ジメチルシリレンビス (シクロペンタ ジエニル) ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレンビス (メチルシクロペン タジエニル)ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス(ジメチルシクロペ ンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス (テトラヒドロイ ンデニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレン (シクロペンタジエニル) (フルオレニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレン (シクロペンタジエ ニル)(フルオレニル)ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレン(メチルシ クロペンタジエニル)(フルオレニル)ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリ レンビス (3-トリメチルシリルシクロペンタジエニル) ジヒドリドジルコニウ ム、ジメチルシリレンピス(インデニル)ジメチルジルコニウム、ジフェニルシ リレンピス(インデニル)ジクロロジルコニウム、フェニルメチルシリレンビス (インデニル) ジクロロジルコニウムおよびこれら化合物のジルコニウムをハフ ニウムで置換した化合物などがあげられる。これらの中でもC₁対称、C₉対称、 Cs対称のものからは、立体規則性リビング重合体を得ることができる。

[0031]

IVB族化合物(A)および場合により後述するアルミニウム化合物(C)とともに本発明に用いる触媒を構成する(B)成分のうちのボラン化合物(B-1)は、前述のごとく、一般式(I):

$$B(Ph)_{3} \qquad (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物であり、ボレート化合物(B-2)は、一般式(II):

$$B^-(Ph)_AX^+$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物である。これらは組み合わせて用いてもよい。

[0032]

一般式(I)中の置換されていてもよいフェニル基としては、たとえばフェニル基、フェニル基に含まれる5個の水素原子のうちの1~5個が他の基、たとえばフッ素原子、炭素数1~20のアルキル基、フッ素原子で置換された炭素数1~20のアルキル基などで置換された基、具体的には、モノフルオロフェニル基、ジフルオロフェニル基、トリフルオロフェニル基、テトラフルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、フルオロメチルフェニル基、ジ(トリフルオロメチル)フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基などがあげられる。これらのうちでは、フェニル基に含まれる5個の水素原子のうちの1~5個がフッ素原子に置換された基、とくに5個の水素原子がいずれもフッ素原子に置換された基であるのが、工業的に入手しやすい点から好ましい。

[0033]

一般式(I)に含まれる3個の置換されていてもよいフェニル基は同じ基であってもよく、異なる基であってもよいが、3個の基にフッ素原子が合計3個以上、とくには15個含まれているのが、工業的に入手しやすい点から好ましい。

[0034]

ボラン化合物(B-1)の具体例としては、たとえばトリフェニルホウ素、トリス(2-7ルオロフェニル)ホウ素、トリス(3-7ルオロフェニル)ホウ素、トリス(4-7ルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3-30ルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3, 5-30ルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3, 4, 6-71カフルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3, 4, 6-71カフルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3, 4, 4-71カロスニル)ホウ素、トリス(20カロスニル)ホウ素、トリス(21カロステルフェニル)ホウ素、トリス(21カロステルフェニル)ホウ素、トリス(22カロストリス(23, 24カロストリス(25カロストリス(27カロストリス)ホウ素などがあげられる。

[0035]

一般式 (II) 中の置換されていてもよいフェニル基は、一般式 (I) 中のものと同じであるので、説明は省略する。

[0036]

一般式(II)に含まれる4個の置換されていてもよいフェニル基は同じ基であ

ってもよく、異なる基であってもよいが、4個の基にフッ素原子が合計4個以上 、とくには20個含まれているのが、工業的に入手しやすい点から好ましい。

[0037]

一方、一般式(II)中に含まれる陽イオン基である X^+ としては、たとえばトリエチルアンモニウム、トリ(n ーブチル)アンモニウム、トリメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、メチルトリ(n ーブチル)アンモニウム、ベンジルトリ(n ーブチル)アンモニウム、ダメチルジフェニルアンモニウム、メチルトリフェニルアンモニウム、トリメチルアニリニウム、メチルピリジニウム、ベンジルピリジニウム、メチル(2 ーシアノピリジニウム)、トリメチルスルホニウム、ベンジルジメチルスルホニウム、トリフェニルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム、メチルジフェニルアンモニウム、アニリニウム、メチルアニリニウム、ジメチル(n ーニトロアニリニウム)、ジメチル(n ーブロモアニリニウム、バンジルピリジニウム、n ーシアノピリジニウム、n ーシアノーNーメチルピリジニウム、n ーシアノーNーメチルピリジニウム、n ーシアノーNーメチルピリジニウム、n ーシアノーNーメチルピリジニウム、n ーシアノーNースチンジルピリジニウム、n ーシアノーNースホニウム、トリテルなどがあげられる。

[0038]

一般式 (II) で表わされるボレート化合物 (B-2) の具体例としては、たとえばテトラフェニルボレートトリエチルアンモニウム、テトラフェニルボレートトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェニルボレートトリメチルアンモニウム、テトラフェニルボレートテトラエチルアンモニウム、テトラフェニルボレートベンジルトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェニルボレートベンジルトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェニルボレートジメチルジフェニルアンモニウム、テトラフェニルボレートメチルトリフェニルアンモニウム、テトラフェニルボレートトリメチルアニリニウム、テトラフェニルボレートメチルピリジニウム、テトラフェニルボレートベンジルピリジニウム、テトラフェニルボレートトリメチルスルボレートトリメチルスルホニウム、テトラフェニルボレートベンジルジメチルスルホニウム、テトラフェニルボレートベンジルジメチルスルホニウム、テトラフェニルボレートベンジルジメチルスルホニウム、テトラフェニルボレートベンジルジメチルスルホニウム、テトラ

フェニルボレートトリチルなどのテトラフェニルボレートイオンを有する化合物 、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートトリエチルアンモニウム、テ トラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートトリ(nーブチル)アンモニウム 、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートトリフェニルアンモニウム、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートテトラブチルアンモニウム、テ トラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(テトラエチルアンモニウム)、 テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(メチルトリ(nープチル)ア ンモニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(ベンジルトリ (n-ブチル) アンモニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレー トメチルジフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレ ートメチルトリフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレートジメチルジフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル) ボレートアニリニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレートメ チルアニリニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートジメチルア ニリニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートトリメチルアニリ ニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートジメチル(mーニトロ アニリニウム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートジメチル (p ーブロモアニリニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートピリ ジニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート (pーシアノピリジ ニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(N-メチルピリジ ニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(N-ベンジルピリ ジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(o-シアノーN -メチルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(p **ーシアノーN-メチルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)** ボレート (p-シアノーN-ベンジルピリジニウム)、テトラキス (ペンタフル オロフェニル) ボレートトリメチルスルホニウム、テトラキス(ペンタフルオロ フェニル) ボレートベンジルジメチルスルホニウム、テトラキス (ペンタフルオ ロフェニル) ボレートテトラフェニルホスホニウム、テトラキス (ペンタフルオ ロフェニル) ボレートトリチル、テトラキス(3,5-ジトリフルオロメチルフ ェニル) ボレートジメチルアニリニウムなどのテトラキス (フッ素原子含有フェニル) ボレートイオンを有する化合物などがあげられる。

[0039]

IVB族化合物(A)および一般式(I)または(II)で表わされるホウ素含有化合物(B)とともに、場合により本発明に用いられる触媒を構成するアルミニウム化合物(C)は、前述のごとく、一般式(III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲン原子、アルコキシ基、トリアルキルシロキシ基、ジ(トリアルキルシリル)アミノ基またはトリアルキルシリル基など、nは0.1または2)で表わされるアルミニウム化合物である。アルミニウム化合物(C)は、いわゆるスカベンジャー(不純物捕捉剤)であり、系に不純物が含まれない場合には用いなくてもよいが、通常、用いることにより、用いない場合と比較して安定にリビング重合体を得ることができる。

[0040]

一般式 (III) に含まれるRである炭素数4~20の炭化水素基の具体例としては、たとえばn-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、デシル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、フェニル基などがあげられる。

[0041]

一般式 (III) に含まれるRの数は1~3個であり、炭素数4~20の場合には、連鎖移動をうけにくく、リビング重合体が得られやすくなる。また、Rの数が3個であるのが好ましい。一般式 (III) に含まれるRの数が2個以上の場合、それらは同じ基であってもよく、異なる基であってもよい。

[0042]

なお、Yの数は0~2個であり、Yの具体例としては、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基、フェノキシ基などの炭素数1~2 0のアルコキシ基、トリアルキルシロキシ基(アルキル基の炭素数1~20)、 ジ(トリアルキルシリル)アミノ基(アルキル基の炭素数1~20)、トリアル キルシリル基(アルキル基の炭素数 $1 \sim 20$)などがあげられる。一般式(III)に含まれるYの数が2個の場合、それらは同じ基であってもよく、異なる基であってもよい。

[0043]

アルミニウム化合物 (C) の具体例としては、たとえばトリ (n-ブチル) ア ルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリsec-ブチルアルミニウム、 トリ (t-ブチル) アルミニウム、トリペンチルアルミニウム、トリイソペンチ ルアルミニウム、トリネオペンチルアルミニウム、トリ(4-メチルペンチル) アルミニウム、トリ (3-メチルペンチル) アルミニウム、トリヘキシルアルミ ニウム、トリイソヘキシルアルミニウム、トリ(n-オクチル)アルミニウム、 トリ2-エチルヘキシルアルミニウム、トリデシルアルミニウムなどのトリアル キルアルミニウム; トリシクロペンチルアルミニウム、トリシクロヘキシルアル ミニウム、トリシクロオクチルアルミニウムなどのトリ環状アルキルアルミニウ ム;トリフェニルアルミニウム、トリャートリルアルミニウム、トリェートリル アルミニウム、トリρーエチルフェニルアルミニウム、トリベンジルアルミニウ ムなどのトリ芳香族アルミニウム;ジ(n-ブチル)アルミニウムクロリド、ジ イソブチルアルミニウムクロリド、ジ (t-ブチル) アルミニウムクロリド、ジ オクチルアルミニウムアイオダイドなどのジアルキルアルミニウムハライド;ジ イソブチルアルミニウムメトキシド、ジイソブチルアルミニウムエトキシド、ジ オクチルアルミニウムメトキシド、ジオクチルアルミニウムエトキシド、ジェー ブチルアルミニウムフェノキシドなどのジアルキルアルミニウムアルコキシド; nーブチルアルミニウムジクロライド、イソブチルアルミニウムジクロライド、 オクチルアルミニウムジクロライドなどのアルキルアルミニウムジハライド; n ーブチルアルミニウムセスキクロリドなどのアルキルアルミニウムセスキハライ ド;ジイソブチルアルミニウムトリメチルシリルオキシド((iso-Bu) $_2$ $AlosiMe_3$)、ジイソブチルアルミニウムトリエチルシリルオキシド((iso-Bu)₂A1OSiEt₃)、ジイソブチルアルミニウムジ(トリメチル シリル) アミン ((iso-Bu)₂AlN (SiMe₃)₂、ジイソブチルトリ メチルシリルアルミニウム ((iso-Bu) $_2$ AlSiMe $_3$) などがあげられ る。これらのうちではトリオクチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム が工業的に入手しやすく安価である点から好ましい。

[0044]

本発明に用いられるIVB族化合物(A)(以下、化合物(A)ともいう)、ホウ素含有化合物(B)(以下、化合物(B)ともいう)および場合により使用されるアルミニウム化合物(C)からなる触媒は、化合物(A)、化合物(B)および場合により化合物(C)を所定の割合で混合し、反応させることにより得ることができる。

[0045]

得られた触媒はそのまま使用してもよく、分離、洗浄して使用してもよい。重 合系内で触媒を製造し、そのまま使用するのが簡便である点から好ましい。

[0046]

前記触媒を製造する際の化合物(A)と化合物(B)の使用割合としては、化合物(A)/化合物(B)がモル比で1/0.1~1/100、さらには1/1~1/5であるのが、目的とする触媒が効率よく得られる点から好ましい。前記割合が大きすぎると、触媒の生成率が低くなる傾向が生じ、逆に小さすぎると不必要な化合物(B)の使用は不経済となる。

[0047]

また、化合物(A)と化合物(C)の使用割合としては、化合物(A)/化合物(C)がモル比で1/0~1/1000、さらには1/10~1/500であるのが系に不純物が存在する場合に捕捉する点から好ましい。化合物(A)に対する化合物(C)の割合が少なすぎると系に不純物が存在する場合には捕捉しにくくなり、多くなりすぎると、化合物(C)由来物を重合体から除去しにくくなる。

[0048]

化合物(A)、化合物(B)および場合により化合物(C)を混合し、反応させる際の条件としては、-100℃~室温、さらには-100~-20℃、不活性気体雰囲気下、後述する重合溶媒などの溶媒中で反応させることにより行なうのが、反応プロセスから重合プロセスに移行しやすい点から好ましい。

[0049]

本発明に用いられる好ましい触媒の具体例としては、たとえば後述する実施例に記載の触媒などがあげられる。なお、実施例11~12で使用しているシクロペンタジエニルハフニウムメチルジクロライドは新規物質である。

[0050]

このようにして調製された触媒の存在下、ハフニウム含有化合物(A-1)を使用する場合には、 $-20\sim-100$ ℃、さらには $-30\sim-80$ ℃、とくには $-40\sim-80$ ℃、ジルコニウム含有化合物(A-2)を使用する場合には、 $-60\sim-100$ ℃、さらには $-60\sim-80$ ℃でオレフィン系モノマーを重合させることにより、分子量分布(Mw/Mn)が $1\sim1$. 3、さらには $1\sim1$. 2のオレフィン系リビング重合体を製造することができる。前記温度が高すぎると、連鎖移動反応が無視できなくなり、リビング重合体が得られにくくなる。前記温度が低すぎると、リビング重合速度が遅くなる傾向が生じる。

[0051]

前記触媒の使用量としては、オレフィン系モノマー/触媒(化合物(A)または化合物(B)のうち少ない方の量になる)がモル比で $10\sim10^9$ 、さらには $100\sim10^7$ 、とくには $100\sim10^5$ とするのが好ましい。前記モル比率が小さすぎると、分子量の小さい重合体しか得られなくなり、大きすぎると、モノマーに対するポリマーの収率が低くなる傾向が生ずる。

[0052]

前記触媒は重合溶媒を用いる場合、重合溶媒に予め加えておいてもよく、重合系内にあとから加えてもよい。

[0053]

前記重合溶媒としては、たとえばベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素;シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素;ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;クロロホルム、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素などを用いることができる。これらの溶媒は単独で用いてもよく、2種以上を組み合せて用いてもよい。また、αーオレフィンなどのモノマーを溶媒として用いても

よい。

[0054]

他の重合条件には、とくに限定はなく、当業者であれば適宜好ましい条件を選択することができるが、重合時間は通常10分~100時間、反応圧力は常圧100kg/cm 2 Gである。

[0055]

このようにして、GPCによる数平均分子量500~200000、さらには1000~100000、とくには2000~50000、分子量分布1.3以下、さらには1.2以下、とくには1.1以下のオレフィン系リビング重合体が製造される。

[0056]

なお、通常、重合中に重合体は析出しないが、エチレンやプロピレン(立体規則性重合時)や環状オレフィンなどの単独重合では、重合体が結晶化しやすい場合があり、そのような場合には重合中に重合体が析出し、分子量分布が広がる傾向がある。重合中に重合体が析出しにくく、分子量分布が狭い分子量としては、3000以下、好ましくは2000以下、さらに好ましくは1000以下、最も好ましくは500以下である。重合中に結晶化や析出をしにくくするために、これらのモノマーを共重合させることも好ましい。

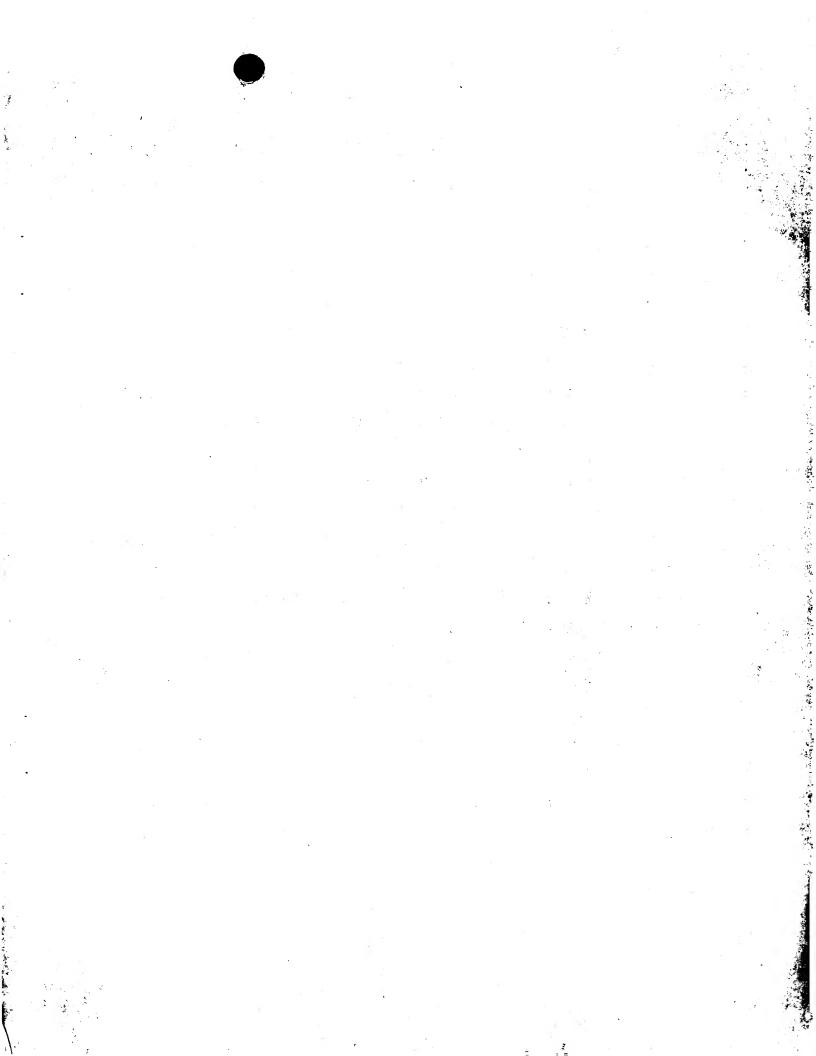
[0057]

製造されたリビング重合体の評価は、一般に(a)生成する重合体の分子量分布が極めて狭い(単分散に近い)こと、(b)時間の増加に伴い、重合体収量数平均分子量(Mn)が比例的に増加し、しかも分子量分布が広がらないことなどに基づき行なわれる。

[0058]

前記のリビング重合体は、一酸化炭素などの適当な反応性を有する試薬と接触させることにより、分子末端にIVB族遷移金属をもたないいわゆる末端官能化重合体にすることができる。また、ブロックコポリマーに変換する場合には、適当な異種モノマーと接触させて多段階重合を行なうことにより、高収率でブロックコポリマーを得ることができる。

	, *,
•	
•	
31	
÷	•
	•
	Ŷ
	•
	·





[0059]

【実施例】

つぎに、本発明を実施例および比較例に基づいてより具体的に示すが、本発明 は下記実施例に限定されるものではない。

[0060]

実施例1~2

充分乾燥させた100mLのオートクレーブに、乾燥トルエン14.4ml、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmolを添加し、-78℃に冷却した。ピスシクロペンタジエニルジルコニウムジメチル0.04mmol、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmol、プロピレン83mmolを加え、実施例1の場合は3時間、実施例2の場合は12時間重合させた。そののち、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、重合体を析出させた。析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0061]

ポリマーの収量(Yield)は、実施例1の場合89mg、実施例2の場合291mgであった。GPCにより測定した数平均分子量(Mn)および分子量分布(Mw(重量平均分子量)/Mn)は、実施例1の場合9400および1.06、実施例2の場合27300および1.15であった。

[0062]

以上のように分子量分布の狭いポリマーが得られた。

[0063]

また、時間と数平均分子量との関係および時間と収量との関係を図1に示す。

[0064]

図1から、時間と数平均分子量とが比例的であることがわかる。また、時間と 収量とも比例的であることがわかる。これらの結果からも、前記重合がリビング 重合であることがわかる。

[0065]

比較例1

充分乾燥させた100mLのオートクレーブに、乾燥トルエン14.4ml、

トリ(n-オクチル)アルミニウム 0.8 mm o 1 を添加し、-50℃に冷却した。ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジメチル 0.04 mm o 1、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素 0.04 mm o 1、プロピレン83 mm o 1を加え、比較例 1 の場合は 6 時間重合させた。そののち、塩酸性メタノール 1 0 0 m 1 に注いで重合を停止させ、重合体を析出させた。析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0066]

ポリマーの収量(Yield)は1110mgであった。GPCにより測定した数平均分子量(Mn)および分子量分布(Mw/Mn)は、46300および1.55であった。

[0067]

以上のように分子量分布の広いポリマーしか得られなかったことから、重合が 必ずしもリビング的に進行していないことがわかる。

[0068]

実施例3~5

充分乾燥させた100mLのオートクレーブに、乾燥トルエン14.4m1、トリ(nーオクチル)アルミニウム0.8mmo1を添加し、一50℃に冷却した。ビスシクロペンタジエニルハフニウムジメチル0.04mmo1、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、実施例3の場合は3時間、実施例4の場合は15時間、実施例5の場合は24時間重合させた。そののち、塩酸性メタノール1000m1に注いで重合を停止させ、重合体を析出させた。析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た

[0069]

ポリマーの収量(Yield)は、実施例3の場合88mg、実施例4の場合460mg、実施例5の場合650mgであった。GPCにより測定した数平均分子量(Mn)および分子量分布(Mw/Mn)は、実施例3の場合6000および1.08、実施例4の場合23200および1.04、実施例5の場合34300および1.05であった。

[0070]

以上のように分子量分布の狭いポリマーが得られた。

[0071]

また、時間と数平均分子量の関係および時間と収量の関係を図2に示す。

[0072]

図2から、時間と数平均分子量とが比例的であることがわかる。また、時間と 収量とも比例的であることがわかる。これらの結果からも、前記重合がリビング 重合であることがわかる。

[0073]

実施例6~7

充分乾燥させた100mLのオートクレーブに、乾燥トルエン14.4ml、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmo1を添加し、-78℃に冷却した。ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジクロライド0.04mmo1、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、実施例6の場合は6時間、実施例7の場合は12時間重合させた。そののち、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、重合体を析出させた。析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0074]

ポリマーの収量(Yield)は、実施例6の場合2.0mg、実施例7の場合10mgであった。GPCにより測定した数平均分子量(Mn)および分子量分布(Mw/Mn)は、実施例6の場合1100および1.20、実施例7の場合3900および1.23であった。

[0075]

以上のように分子量分布の狭いポリマーが得られた。

[0076]

また、時間と数平均分子量の関係および時間と収量の関係を図3に示す。図3 から、誘導期が存在するものの時間と数平均分子量とが比例的であることがわか る。また、時間と収量とも比例的であることがわかる。これらの結果からも、前 記重合がリビング重合であることがわかる。 [0077]

実施例8~10

充分乾燥させた100mLのオートクレーブに、乾燥トルエン11.0ml、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmolを添加し、-78℃に冷却した。rac-エチレンビスインデニルジルコニウムジメチル0.04mmol、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmol、ヘキサン83mmolを加え、実施例8の場合は5時間、実施例9の場合は12時間、実施例10の場合は14時間重合させた。そののち、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、重合体を析出させた。析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0078]

ポリマーの収量(Yield)は、実施例8の場合10mg、実施例9の場合21mg、実施例10の場合28mgであった。GPCにより測定した数平均分子量(Mn)および分子量分布(Mw/Mn)は、実施例8の場合2300および1.27、実施例9の場合4300および1.22、実施例10の場合5400および1.29であった。

[0079]

以上のように分子量分布の狭いポリマーが得られた。

[0080]

また、時間と数平均分子量の関係および時間と収量の関係を図4に示す。

[0081]

図4から、時間と数平均分子量とが比例的であることがわかる。また、時間と 収量とも比例的であることがわかる。これらの結果からも、前記重合がリビング 重合であることがわかる。

[0082]

また、図5に実施例10で得られた重合体の¹³C-NMRシグナルを示す。図5に示されるように、各炭素のシグナルは、ほぼ単一であり、立体規則性の高い重合体であることもわかる。

[0083]

実施例11~12

シクロペンタジエニルハフニウムトリクロライド(5g、14.3mmol)の乾燥エーテル溶液150mlに、メチルリチウム(1.14M、44.4mmol)のエーテル溶液39mlを、窒素雰囲気下-78℃で1時間かけて滴下した。室温に戻しながら約40時間撹拌したのち、エーテルを真空下で留去し、50mlの乾燥ヘキサンに可溶な部分を濾別した。ヘキサンを真空下で一部留去し、ついで-25℃で約40時間放置し、生成した白色針状結晶を濾別した。真空乾燥後、収量を測定し、¹H NMR分析を行なった。

[0084]

収量:1.30g(27.6%)

 1 H NMR (CDC1₃): δ 6. 02(s, 5H), -0. 60(s, 3H) [0085]

充分乾燥させた100mLのオートクレーブに、乾燥トルエン14.4ml、トリ (n-オクチル) アルミニウム0.8mmolを添加し、-50℃に冷却した。シクロペンタジエニルハフニウムメチルジクロライド0.04mmol、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素0.04mmol、プロピレン83mmolを加え、実施例11の場合は6時間、実施例12の場合は22時間重合させた。塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、重合体を析出させた。析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0086]

ポリマーの収量 (Yield) は、実施例11の場合189mg、実施例12 の場合1130mgであった。GPCにより測定した数平均分子量 (Mn) および分子量分布 (Mw/Mn) は、実施例11の場合8300および1.06、実施例12の場合46200および1.14であった。

[0087]

以上のように分子量分布の狭いポリマーが得られた。

[0088]

また、時間と数平均分子量の関係および時間と収量の関係を図6に示す。

[0089]

図6から、時間と数平均分子量とが比例的であることがわかる。また、時間と 収量とも比例的であることがわかる。これらの結果からも、前記重合が、リビン グ重合であることがわかる。

[0090]

実施例13~14

充分乾燥させた100mLのオートクレーブに、乾燥トルエン14.4ml、トリ(イソブチル)アルミニウム0.8mmo1を添加し、-78℃に冷却した。ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジメチル0.04mmo1、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、実施例13の場合は3時間、実施例14の場合は12時間重合させた。塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、重合体を析出させた。析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0091]

ポリマーの収量(Yield)は、実施例13の場合30mg、実施例14の場合150mgであった。GPCにより測定した数平均分子量(Mn)および分子量分布(Mw/Mn)は、実施例13の場合2700および1.23、実施例14の場合10300および1.04であった。

[0092]

以上のように分子量分布の狭いポリマーが得られた。

[0093] .

また、時間と数平均分子量の関係および時間と収量の関係を図7に示す。

[0094]

図7から、時間と数平均分子量とが比例的であることがわかる。また、時間と 収量とも比例的であることがわかる。これらの結果からも、前記重合が、リビン グ重合であることがわかる。

[0095]

【発明の効果】

本発明によれば、化合物(A)、化合物(B)および場合により化合物(C)からなる触媒を用いて低温で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させ

ることにより、分子量分布が1.3以下のポリオレフィン系リビング重合体を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例1~2で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間 との関係を示すグラフである。

【図2】

実施例3~5で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間 との関係を示すグラフである。

【図3】

実施例6~7で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間 との関係を示すグラフである。

【図4】

実施例8~10で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間との関係を示すグラフである。

【図5】

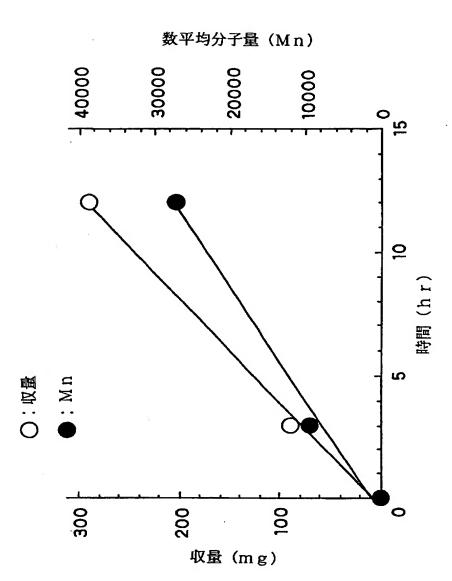
実施例10で得られた重合体の 13 C-NMRシグナルを示す図である。

【図6】

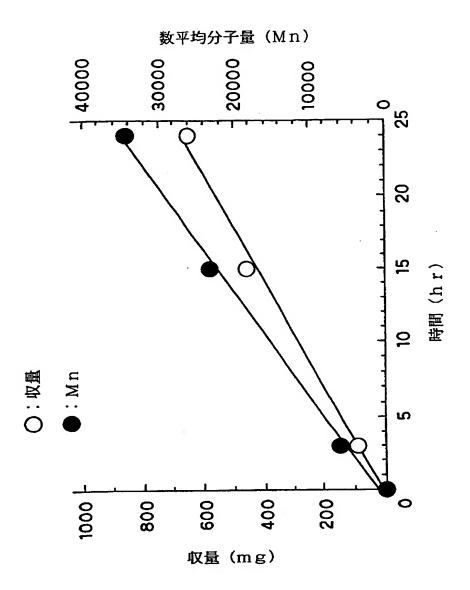
実施例11~12で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応 時間との関係を示すグラフである。

【図7】

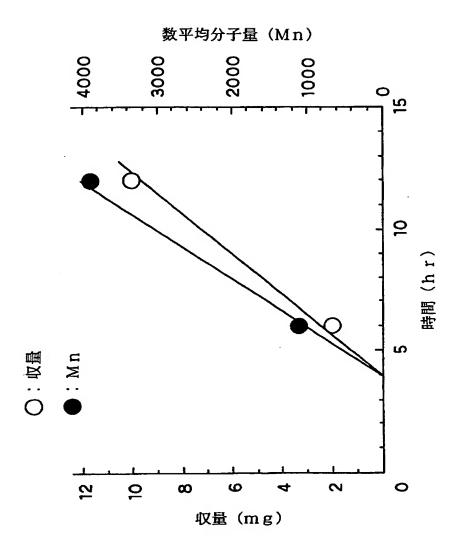
実施例13~14で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応 時間との関係を示すグラフである。 【書類名】図面【図1】



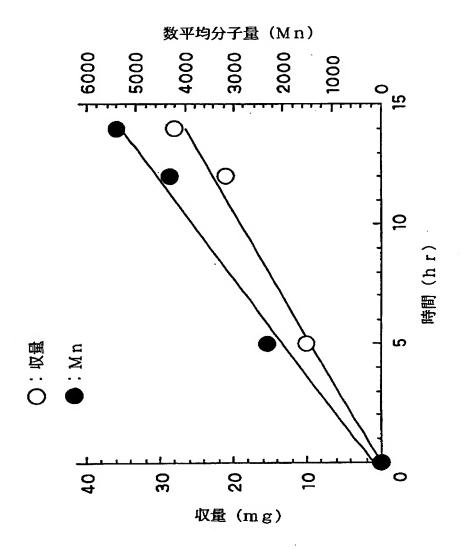
【図2】



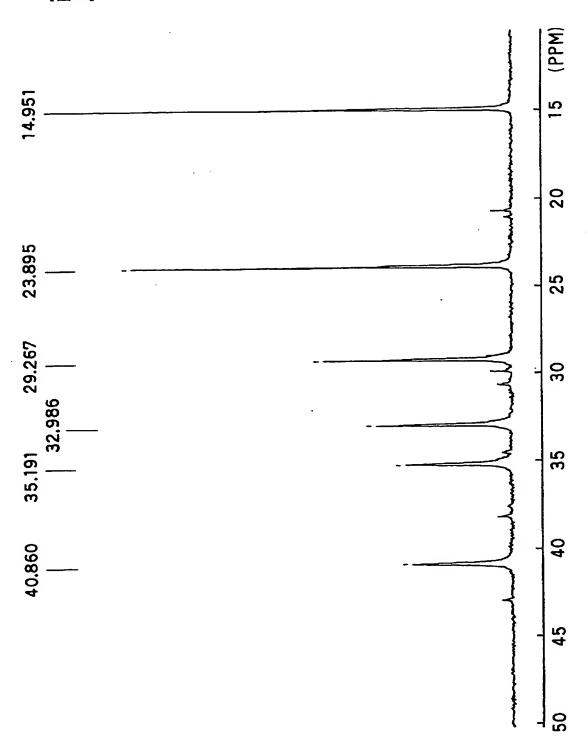
[図3]



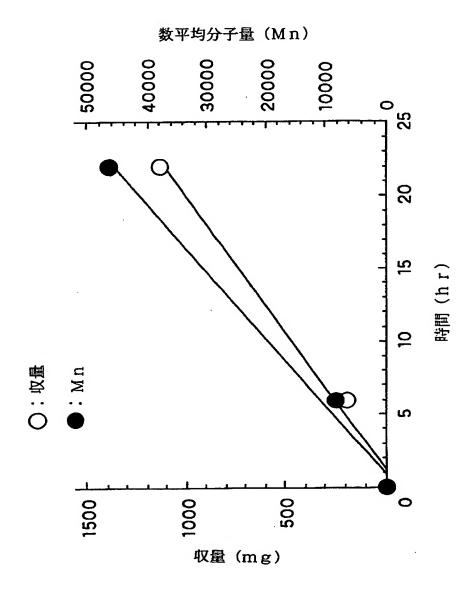
【図4】



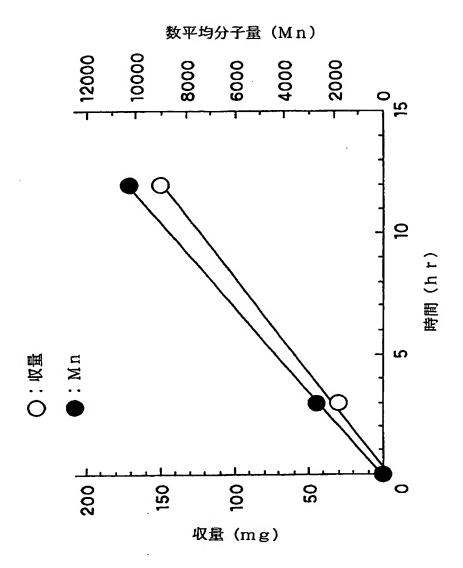




【図6】



【図7】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 末端官能化ポリマーやブロックコポリマーに変換し得るオレフィン系 リビング重合体を製造する。

【解決手段】 (A) 1 個または 2 個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウムまたはジルコニウム含有化合物、(B) トリフェニルホウ素系化合物またはテトラフェニルホウ素塩系化合物および場合により特定のモノ、ジまたはトリアルキルアルミニウム系化合物からなる触媒を用いて低温で炭素数 2~20のオレフィン系モノマーを重合させて分子量分布(Mw/Mn)が1~1.3のオレフィン系リビング重合体を製造する。

【選択図】

なし

認定 · 付加情報

特許出願の番号 平成11年 特許願 第128732号

受付番号 59900437282

書類名特許願

担当官 清水 スズ子 1350

作成日 平成11年 7月13日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001144

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

【氏名又は名称】 工業技術院長

【特許出願人】

【識別番号】 597071652

【住所又は居所】 東京都台東区柳橋2丁目22番13号

【氏名又は名称】 財団法人 化学技術戦略推進機構

【指定代理人】

【識別番号】 220000390

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1

【氏名又は名称】 工業技術院物質工学工業技術研究所長

【代理人】 申請人

【識別番号】 100065226

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【復代理人】 申請人

【識別番号】 100065226

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル

7階 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【選任した復代理人】

次頁有

認定・付加情報 (続き)

100098257

【識別番号】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル

7階 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【書類名】 手続補正書

【整理番号】 JP-11390

【提出日】 平成11年 5月31日

【あて先】 特許庁長官 伊佐山 建志 殿

【事件の表示】

【出願番号】 平成11年特許願第128732号

【補正をする者】

【識別番号】 000001144

【氏名又は名称】 工業技術院長 佐藤 壮郎

【補正をする者】

【識別番号】 597071652

【氏名又は名称】 財団法人化学技術戦略推進機構

【復代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の復代理人

【代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 財団法人 化学技術戦略推進機構の 代理人

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 持分契約書

【補正方法】 追加

【補正の内容】

【提出物件の目録】

【物件名】

持分契約書 1

29910200209

持 分 契 約 書

平成 11年 5 月10日

事件の表示

平成 11年 5 月 10日付特許願

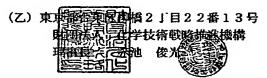
整理番号

JP-11390

(発明の名称 オレフィン系リビング重合体の製はおよびシクロ) ベンタジエニルハフニウムメチルジクロライド

上記発明の特許を受ける権利の持分を甲34%、乙66%と定めたことに 相違ありません。

> (甲) 東京都千代田区霞が関1丁日3番1号 工業技術院長 佐藤 壮郎 指定代理人 茨城県つくば市東1丁目1番 工業技術院物質工学工業技術研究所長 久保田 正明



工業技術院職務発明規程・工業技術院共同研究規程等により持分の決定は工業技術院 長に代わり指定代理人である各研究所長が行う旨規程している。

認定・付加情報

特許出願の番号

平成11年 特許願 第128732号

受付番号

29910200209

書類名

手続補正書

担当官

清水 スズ子

1350

作成日

平成11年 7月13日

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】

000001144

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

【氏名又は名称】

工業技術院長

【補正をする者】

【識別番号】

597071652

【住所又は居所】

東京都台東区柳橋2丁目22番13号

【氏名又は名称】

財団法人 化学技術戦略推進機構

【復代理人】

申請人

【識別番号】

100065226

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】

朝日奈 宗太

【代理人】

申請人

【識別番号】

100065226

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

1

【氏名又は名称】

朝日奈 宗太

【提出された物件の記事】

【提出物件名】

持分契約書

出願人履歴情報

識別番号

[000001144]

1. 変更年月日 1990年 9月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

氏 名 工業技術院長

出願人履歴情報

識別番号

[597071652]

1. 変更年月日 1998年 3月26日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都台東区柳橋2丁目22番13号

氏 名 財団法人 化学技術戦略推進機構